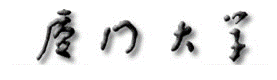
**学校编码：10384 分类号 密级**

**学 号：23120141153109 UDC**



硕 士 学 位 论 文

**G-FET器件制备系统开发及其关键技术研究**

**Development and key technology research of G-FET device preparation system**

陈金龙

指导教师姓名：郭东辉 教授

专 业 名 称：电子与通信工程

论文提交日期：20 年 月

论文答辩时间：20 年 月

学位授予日期：20 年 月

答辩委员会主席：

评 阅 人：

201 年 月

**厦门大学学位论文原创性声明**

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月

**厦门大学学位论文著作权使用声明**

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于　　 年　 月 　日解密，解密后适用上述授权。

（ ）2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

**摘 要**

**关键词：**

**Abstract**

**Keywords:**

目 录

**[摘 要](#_Toc4517)** [4](#_Toc4517)

**[Abstract](#_Toc19671)** [5](#_Toc19671)

[目 录 6](#_Toc13137)

[第一章 绪论 9](#_Toc8550)

[1.1 引言 9](#_Toc30090)

[1.2 相关技术发展现状 9](#_Toc21794)

[1.3 关键技术及其研究进展 9](#_Toc15552)

[1.3.1 μCVD结构设计技术 9](#_Toc25449)

[1.3.2 μCVD温度测控技术 9](#_Toc17620)

[1.3.3 μCVD显微成像技术 9](#_Toc5773)

[1.4 论文工作及章节安排 9](#_Toc7400)

[1.4.1 论文主要研究内容 9](#_Toc16116)

[1.4.2 章节安排 9](#_Toc617)

[第二章 GFET的结构特征与制备工艺 9](#_Toc8307)

[2.1 场效应管的基本结构与特征 10](#_Toc7559)

[2.1.1 场效应管的基本结构 10](#_Toc12127)

[2.1.2 场效应管的工作原理与特性 10](#_Toc29325)

[2.2 GFET的基本结构与特性 10](#_Toc17177)

[2.2.1 石墨烯场效应管的基本结构 10](#_Toc13986)

[2.2.2 石墨烯场效应管的工作原理与特性 10](#_Toc21038)

[2.3 μCVD生长GFET工艺简介（最近uCVD长纳米管文献） 10](#_Toc27653)

[2.3.1 石墨烯特性与工艺目标（是否要放在第二节） 10](#_Toc11326)

[2.3.2 μCVD法石墨烯转移技术 10](#_Toc2246)

[2.3.3 μCVD法GFET生长原理和流程 10](#_Toc2115)

[2.4 本章小结 10](#_Toc17532)

[第三章 用于生长石墨烯的μCVD微芯片设计 10](#_Toc12787)

[3.1](#_Toc19604) [μCVD系统的理论模型分析 11](#_Toc19604)

[3.1.1 温度稳定时间模型 11](#_Toc14162)

[3.1.2 气体交换速率模型 11](#_Toc23591)

[3.1.3 气体流动状态模型 11](#_Toc16301)

[3.2](#_Toc23421) [μCVD微芯片软件建模与仿真 11](#_Toc23421)

[3.2.1 ANSYS有限元分析软件简介 11](#_Toc16278)

[3.2.2 μCVD微芯片结构设计及比较 11](#_Toc3237)

[3.2.3 μCVD微芯片多物理场耦合仿真 11](#_Toc6553)

[3.3 仿真结果与讨论 11](#_Toc13769)

[3.4 本章小结 11](#_Toc31170)

[第四章 μCVD温度测控系统 11](#_Toc32553)

[4.1 温度检测技术原理 13](#_Toc27183)

[4.1.1 温度检测技术简介 13](#_Toc10718)

[4.1.2 基于红外辐射的测温原理 13](#_Toc20795)

[4.1.3 温度检测系统误差分析 13](#_Toc11738)

[4.2 温度控制技术原理 13](#_Toc19978)

[4.2.1 \*\*\*\* 13](#_Toc191)

[4.2.2 \*\*\*\* 13](#_Toc20100)

[4.2.3 \*\*\*\* 13](#_Toc5242)

[4.3 温度测控系统硬件设计 13](#_Toc20983)

[4.3.1 硬件开发平台介绍 13](#_Toc21459)

[4.3.2 硬件整体原理图及PCB设计 13](#_Toc9721)

[4.4 温度测控系统软件设计 13](#_Toc21574)

[4.4.1 软件开发平台介绍 13](#_Toc5964)

[4.4.2 温度检测程序设计 13](#_Toc28648)

[4.4.3 温度控制程序设计 13](#_Toc7873)

[4.5 本章小结 13](#_Toc20254)

[第五章 μCVD显微成像系统 14](#_Toc4731)

[5.1 自动聚焦技术 15](#_Toc26999)

[5.1.1 传统自动聚焦基本原理 15](#_Toc26110)

[5.1.2 自动聚焦优化算法 15](#_Toc32230)

[5.1.3 优化算子比较及分析 15](#_Toc6118)

[5.2 图像拼接技术 15](#_Toc17961)

[5.2.1 图像拼接原理 15](#_Toc8774)

[5.2.2 图像预处理 15](#_Toc1580)

[5.2.3 图像匹配 15](#_Toc10997)

[5.2.4 图像融合 15](#_Toc24475)

[5.3 显微成像系统设计 15](#_Toc23383)

[5.3.1 显微成像总体设计 15](#_Toc21259)

[5.3.2 图像聚焦模块 15](#_Toc17254)

[5.3.3 图像拼接模块 15](#_Toc25438)

[5.4 本章小结 15](#_Toc2566)

[第六章 μCVD系统使用及说明 16](#_Toc13647)

[6.1 \*\*\*\* 17](#_Toc31973)

[6.2 \*\*\*\* 17](#_Toc5187)

[6.2.1 \*\*\*\* 17](#_Toc25721)

[6.2.2 \*\*\*\* 17](#_Toc20185)

[6.3 \*\*\*\* 17](#_Toc25821)

[6.3.1 \*\*\*\* 17](#_Toc12501)

[6.3.2 \*\*\*\* 17](#_Toc14998)

[6.3.3 \*\*\*\* 17](#_Toc19782)

[6.3.4 \*\*\*\* 17](#_Toc23181)

[6.4 本章小结 17](#_Toc8998)

[第七章 总结与展望 17](#_Toc30395)

[7.1 \*\*\*\* 17](#_Toc14283)

[7.2 \*\*\*\* 17](#_Toc13662)

[参考文献 17](#_Toc24015)

[致 谢 17](#_Toc5808)

# 绪论

## 引言

## 在过去由摩尔定律统治的近半个世纪以来，信息技术进入了飞速发展时期，产业规模、效益也急剧攀升，电子消费类产品、智能穿戴等新兴带有黑科技感的应用层出不穷，日益丰富了人们不断增长的物质精神文明需求。随着云计算、大数据、区块链等技术的异军突起，未来10年智能信息产业将迎来新的变革与布局，而这些技术回归到底层硬件，都得基于集成电路的发展，众所周知，摩尔定律已开始进入瓶颈期，芯片特征尺寸的不断缩小也已经直逼物理极限，也就是说集成电路开始进入后摩尔时代，后摩尔时代使得集成电路发展线路不再明晰、系统复杂度持续增长，这些急需解决的问题使得科研人员朝新的方向去探索。新器件、新结构、新材料的不断研发使得续写摩尔神话成为可能，其中高传输速度的沟道材料——石墨烯成为科研人员的宠儿。

石墨烯是一种二维晶体材料，在平面内具有无限重复的周期结构，垂直方向上拥有一个碳原子的厚度，其实在之前的很久一段时间，大家普遍认为，严格的二维晶体结构由于不具备热稳定性二不能独立存在，更多的是以三维碳纳米材料石墨、金刚石等存在，直到2004年，英国曼彻斯特大学的安德烈· 海姆(Andre Geim)教授和康斯坦丁·诺沃肖诺夫(Kostya Novoselov)博士通过胶带以微机械力高温剥离石墨的方法首次得到石墨烯，但是机械剥离法获取的石墨烯存在效率低，膜厚均匀性差。所以石墨烯的高效可控生长成为一直以来Graphene制备系统开发面临的挑战，同时也掀起了一股石墨烯制备方法的研究热潮。

石墨烯场效应管的研究使集成电路在尺寸和功耗遭遇“天花板”后再次看到春天，而这一切得益于石墨烯材料的大尺寸高效稳定量产，目前相对成熟、得到验证的制备方法有微机械剥离法、热解SiC法、化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition，CVD)法等，各种方法制备效果优劣兼备，权衡利弊，化学气相沉积CVD法以其设备简单、方便量产，转移技术成熟等优点得到广泛应用。

传统化学气相沉积CVD法虽然在同等制备方法上有一定的优势，但是其也存在实验设备沉重、器材昂贵、重复实验时间成本高、反应时间长的问题，所以对石墨烯产出方法高效批量的任务依然任重而道远，如果不在石墨烯材料制备这个源头问题上工夫尽施，那集成电路的未来依旧迷茫。随着微机电加工MEMS的技术日渐完善，传统CVD法微型化为探索石墨烯制备开辟了新的道路，在解决传统CVD法问题的同时，也对石墨烯场效应管的研发不管在基础研究还是工程应用上，都起到了深远的意义。

## 相关技术发展现状

## 

## 关键技术及其研究进展

### μCVD结构设计技术

### μCVD系统测控技术

### μCVD显微成像技术

## 论文工作及章节安排

### 论文主要研究内容

### 章节安排

# GFET的结构特征与制备工艺

# GFET器件制备系统的设计及实现，需要对石墨烯场效应管的微纳结构与设计工艺有全面的了解。本章主要围绕基本场效应管和石墨烯场效应管的结构、工作原理以及特性进行介绍，首先分节独立介绍基本场效应管、石墨烯场效应管的各方面特性参数，提出理想石墨烯场效应管的工艺指标，从而引出传统CVD法和本文提出的μCVD法生长石墨烯的比较，得出μCVD法生长石墨烯的工艺优势，最后探讨μCVD法制石墨烯的工艺流程。

## 场效应管的基本结构与特征

# 信息时代是伴随着元器件的更迭到来的，众所周知，电子管是第一代信息产品的元器件，从诞生之初就不断在与尺寸、重量、可靠性作斗争。1904年，著名英国物理学家弗莱明发明了世界上第一支电子管，也标志着世界进入了电子时代。但是随着历史的不断推移，电子管体积大、功耗大、发热厉害、寿命短等缺点在应用场景的更新中得到充分的暴露。1947年12月16日，威廉·邵克雷(William Shockley)、约翰·巴顿（John Bardeen)和沃特·布拉顿（Walter Brattain）三位伟大的科学家在贝尔实验室研制的世界第一个晶体管预示着信息时代的再次变革，因为晶体管体积小、工艺简单、可靠性高等优点在各种应用场景下弥补了电子管的诸多不足。后来随着平面制作工艺的改进，场效应晶体管也应运而生。

### 场效应管的基本结构

# 场效应管和三极管类似，也是一种具有正向受控作用的半导体器件，有结型(JFET)和金属-氧化物-半导体型(MOSFET)两种类型。

场效应管是以衬底为基础，根据衬底选择P型或N型硅片的不同来进行分类，以P型衬底为例，在衬底两侧扩散两个高掺杂的N+区，分别叫做源区和漏区，与P型衬底构成两个基本的P-N结，在源、漏区分别制作一个欧姆电极用来形成导电回路。衬底表面再生长一层二氧化硅(SiO2)薄膜作为绝缘层，其上制作一个欧姆接触电极，称作栅极，用G表示。在工作状态下，在源极和漏极之间加一个工作电源Vds,源极接正电压，漏极接负电压，同时在接触电极G上引出一个电压VG,其负电压接源极，这样在漏极电压的作用下，场效应管的源区和漏区之间形成N型(即电子型)导电沟道，源区电子通过沟道流向漏区，从而形成自漏区指向源区的电流。

### 场效应管的工作原理与特性

### 场效应管由两个P-N结组成，导电沟道由多子形成，因此又称作单极型半导体器件。通常用到的金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET)根据衬底选择不同分为P型和N型，每一种又有增强型和耗尽型之分，即EMOS和DMOS。

以N沟道EMOS为例，当场效应管的VG大于一定值时，晶体管导通，这个电压值称作导通电压，通常情况下，源极都与衬底极相连，即VS=0。在栅源电压VGS的作用下，源区和漏区之间形成电子型导电沟道，当然为了形成回路，还需要在源区和漏区之间加上VDS，用来产生正向工作电流ID。

首先，VGS=VDS=0，即不给栅源极和栅漏极施加电压，两个掺杂N+区各自形成PN结，因为被空间电荷区所包围，所以彼此隔断，互不影响；接着施加栅源电压VGS，由于栅极以下的SiO2层和衬底之间在VGS作用下形成平板电容器，从而产生指向衬底的电场，该电场吸引N+区的多子电子和衬底中的少子电子，排斥衬底中多子空穴，从而使两个N+区打通，形成空间电荷区，阻断了源区和漏区；当VGS逐步加大时，平板电容器加大吸引电子的力度，直到空间电荷区电子浓度大于空穴浓度，形成电子型导电沟道，并与N+区相通，通常将刚开始形成沟道所需的VGS值称作开启电压VGS(th)；这时，在外加正电压VDS的作用下，源区中掺杂的多子电子通过N沟道漂移至漏区，形成自漏区指向源区的漏极电流，很显然，VGS越大，吸引电子能力越强，N沟道导电能力越强，VDS越大，漏极电流ID相应越大。

当形成导电沟道时，当VDS很小时，它对沟道的变化影响甚微，随着VDS的增大，加在平板电容器的电压大小在发生变化，导致靠近漏极的沟道深度开始变窄，因为沟道电阻与横截面积成反比，横截面积越小电阻越大，ID增速变缓，直到近漏端的沟道完全被夹断。

综上可以得出，场效应管工作原理体现在：1.流经场效应管漏区和源区的电流完全由沟道中多子决定的，故又称作单极性管；2.场效应管是利用工作电压的变化来改变半导体导电沟道的电阻大小，从而改变导通电流的大小。

在描述场效应管的伏安特性时，常用输出特性和转移特性来表示，其中输出特性曲线族公式（2.1）：

 （2.1）

图2.1显示了N沟道EMOS的输出特性曲线，可见图示可划分非饱和区、饱和区、截止区和击穿区四个工作区，分别介绍一下各工作区的特性。

当电压满足不等式：、限定时，场效应管工作在非饱和区，该工作区域内，由、共同决定，见下式：

 （2.2）

式中是自由电子迁移率，是单位面积的栅极电容量，是N沟道的宽度，是沟道长度。由图2.1可以看出与近乎呈线性关系。

饱和区是沟道开始被夹断的工作区域，由电压不等式：、导出，同样可推出漏极电流，式（2.3）显示了的具体过程：

 （2.3）

很显然，式中表示由控制，如果考虑沟道长度调制效应，类似于晶体三极管的基区宽度调制效应，引入厄尔利电压，式（2.3）则修正为：

 （2.4）

由以上几个漏极电流公式可以看出，、、也是重要影响因素，但是集成工艺确定后，这几个参数也为定值，所以在电路设计中，导电沟道的宽长比就成为了改变的重要因子了。

截止区是发生在，即导电沟道还没有形成的时候，没有导电沟道，没有多子迁移的通道，就没有电流形成的条件，因此。

当足够大，大到足以在漏区和衬底间形成的PN结上发生雪崩击穿，这时候剧增，当然，如果过大，也可以导致绝缘层发生破坏性永久性损坏。

## GFET的基本结构与特性

石墨烯凭借着载流子迁移率上超高的表现力赢得了广泛的关注，也因此被认为是续写摩尔定律的不二材料，GFET（石墨烯场效应管）也开始成为众多科研人员的研究重点。早在石墨烯被盖姆教授和诺沃肖诺夫博士在2004年发现时，就报道了石墨烯在室温下的迁移率——10000~15000cm2/Vs，以石墨烯作为导电沟道，代替硅实现超高速晶体管是科研人员不懈奋斗的目标。同时，超高速场效应管应该对输入电压的变化响应极快，可是响应速度受制于沟道宽长，缩短沟道长度，可以提高器件响应时间，这样的话会面临一个问题：器件受到短沟道效应，影响器件稳定性，当然减薄沟道厚度可以缓解短沟道效应，目前以硅等四价元素为主的半导体器件沟道厚度一般在10~15nm，而石墨烯本身就是一个原子层的厚度，不仅克服了短沟道效应，而且实现了超高的响应速度。综上，GFET很大希望能继任目前的半导体器件，成为下一代信息高速路上的基石。

### 石墨烯场效应管的基本结构

### 石墨烯场效应管GFET的基本结构和典型的MOSFET结构类似，其根本区别在于GFET用单原子厚度的新材料石墨烯作导电沟道，根据FET中栅极的位置不同，又将GFET分为顶栅和背栅两种，在顶栅这一类别中，又根据在石墨烯和栅电极之间是否覆盖栅介质，分为局部栅和全栅两种类型。如图，GFET的结构简单，主要组成要素是Si/SiO2衬底、源/栅/漏金属电极、石墨烯导电沟道以及栅介质，衬底、沟道尺寸影响GFET的导电特性，实验过程中需要通过不断调整尺寸配比测试GFET的阈值电压、截止频率等特性来实现其最有性能。在顶栅结构的石墨烯场效应管中，单层石墨烯薄片被转移至Si/SiO2基底上，基于石墨烯转移技术的不断成熟，通过退火工艺使石墨烯层紧紧贴住氧化层，其次在石墨烯薄膜表面生长一定厚度的栅介质层，该层介质不能破坏石墨烯的结构，且具有一定的介电常数，防止给栅极加电压时发生击穿现象，最后就是在源、漏极以及栅介质层表面沉淀金属，制作电极实现欧姆接触。而在背栅结构的GFET中，则要求Si/SiO2衬底重掺杂，同时背栅型不需要生长栅介质层，跟顶栅型类似，需要在源漏极沉积欧姆电阻很小的金属电极来提高器件的响应速率。

### 石墨烯场效应管的工作原理与特性

石墨烯场效应管GFET的工作原理要从石墨烯的三维能带结构来分析，众所周知，石墨烯是由碳原子组成的蜂窝状二维结构，其中的每个碳原子外都有4个价电子，3个价电子与相邻的3个碳原子外的价电子通过sp2杂化形成键，另外一个价电子通过p轨道形成于石墨烯法平面上的键，并且可以自由移动，这是石墨烯具有良好导电性的微观解释。

通过推导得到石墨烯在第一布里渊区的三维能带结构，如图可以看出，石墨烯中碳原子的三维能带近似为两个相对的圆锥，分别为石墨烯的导带和价带。两个能带相交于处在费米能级平面上的6个角点，该角点又称作狄拉克点，所以石墨烯被称是带隙宽度为零的半金属。

图中显示的是典型的GFET沟道电阻R-栅极电压Vg曲线，分析看出，当施加在栅极上一定的电压Vg时，石墨烯的费米能级会发生上下偏移。当加在栅极上的电压Vg为正电压时，石墨烯会感应响应的负电荷来平衡栅极电压形成的电场，石墨烯中费米能级平面处于狄拉克点以上，即石墨烯三维能带中的导带中，此时电子成为石墨烯的导电电荷。当Vg朝负电压方向移动并且经过零点时，同时，石墨烯的费米能级向下移动到狄拉克点，因为此时石墨烯的态密度DOS为零，石墨烯中的载流子密度最低，电阻最大。当Vg继续向负方向增大，则石墨烯的费米能级向下移动到价带，相应地，空穴成为此时石墨烯的导电电荷。由Vg向正负两个方向的不断增大，GFET中导电沟道的电阻也不断减小。因为参与GFET导电的载流子电荷有电子和空穴，所以石墨烯具有双极型特性。

## μCVD生长GFET工艺简介

## μCVD系统生长石墨烯有升降温速率快、石墨烯质量完整等优势，利用生长出来的缺陷极低的石墨烯制作GFET更得到科研工作者们的青睐，相较于传统CVD系统生长石墨烯再加工GFET，μCVD法则具有其自有的制作工艺以及技术要求，这对基于μCVD法生长GFET提出了一定的技术创新能力的要求。本节首先陈述石墨烯作为新材料所具备的各种光、电、力、热等特性，着重介绍其电学特性，以及实验室和工业上形成标准的生长石墨烯的工艺目标，从而探索对μCVD系统生长高质量石墨烯的技术追求和递进方案；其次介绍μCVD法制作GFET中的关键环节——石墨烯转移技术，高效率无损坏的石墨烯转移方案是GFET生长工艺的前提；最后对μCVD系统转移后的石墨烯研制GFET的生长原理和流程进行简单的介绍，并对GFET器件的各种测试指标进行阐述，以达到对最后成型的GFET完成规范的技术考量。

### 石墨烯特性与工艺目标

### 石墨烯是理想的二维结构材料，所谓二维晶体材料，就是指在二维平面上具有无限延展且周期重复的结构，且厚度只有纳米级别的材料。虽然二维材料具有相当多独到的优良特性，但在科学界很长时间内都有普遍认同，并有响应的Peierls理论支撑，严格的二维材料因范德华力不具备热力学稳定性而不能单独稳定存在。事实上，直到2004年两位科学家发现的石墨烯的横空出世，打破了科学界的一致结论，也掀起了国内外科学工作人员对二维碳材料，有其石墨烯的研究热潮。

石墨烯是具有蜂窝状结构的理想二维碳纳米材料，通过石墨烯的卷曲、层叠可以得到富勒烯、碳纳米管和石墨，如图所示。石墨烯中单层碳原子厚度约为0.34nm，其中碳-碳键长0.14nm，碳原子的4个价电子中，3个与相邻的碳原子sp2杂化形成键，另一个价电子在p轨道上形成垂直于石墨烯且自由移动的键，这是石墨烯具有优越导电性的源泉。上文提到石墨烯的三维能带结构看出，石墨烯的导带和价带相交于狄拉克点，费米能级可以在电场的作用下完成在导带和价带之间的上下平移，同时完成载流子导电电荷在电子和空穴之间的转换，故石墨烯具有双极性导电特性。

结构定义特性，作为理想的新材料，石墨烯表现出各种优质特性，尤其在电学特性上的超高载流子迁移率、可调整能带，让人们对它的应用前景充满期待。

1. 电学特性

石墨烯作为特殊的零带隙半导体，在门电场的作用下完成载流子空穴与电子的转换。当施加的门电压为正时，石墨烯的费米能级上提到狄拉克点之上，进入导带中完成电子作为载流子；当门电压为负时，其费米能级下降到狄拉克点以下，空穴进入价带中作为载流子。石墨烯载流子的迁移率达到200000，在目前的导体中也是最大的。利用石墨烯的电学特性研制的各种器件在微电子屏显、生物传感、气体探测等领域发挥着举足轻重的作用。

1. 力学特性

实验证明，石墨烯是如今认识的材料中机械强度最大的，其破坏强度为42，杨氏模量达到1.0，是世界上最好的钢铁强度的100多倍，即使不是纯净的单层石墨烯薄片，在其他物质中掺入石墨烯也能大大提高原物质的机械强度。

1. 光学特性

纯净的石墨烯还具有优异的光学特性，可吸收2.3%的可见光，近似乎透明物质，所以石墨烯97.7%的高透光率足以在未来的可穿戴智能设备的屏显模块占据一席之地，同时，单层石墨烯的比表面积为2630，是碳纳米管的10倍之多。

1. 热学特性

现如今，电子产品的高能耗以及半导体集成电路中的元器件散热问题一直让工程人员头疼不止，而石墨烯的超高导热率达到5000，超快的传热速率是金刚石的3倍，可以作为未来微电子器件的充分材料。

以上的种种特性得益于石墨烯的优良结构，结构缺陷、量产面积小将对石墨烯的应用造成巨大影响，即使某些特性在石墨烯不完整稳定的条件下依旧具备，但是性能大打折扣，所以大尺寸、晶格一致、结构完整一直是石墨烯制备的追求，同时也是巨大的挑战。

### μCVD法石墨烯转移技术

### 不管是传统的CVD制备石墨烯，还是改进型μCVD系统，也不论是对制备的石墨烯进行科研学习还是工程应用，都必须将石墨烯转移到特定的衬底上进行才行，可以看出，石墨烯转移技术的完善与否直接决定了石墨烯的质量好坏以及后期的应用前景，传统的CVD石墨烯转移技术有：基体刻蚀法，“roll-to-roll”法，电化学转移法，下面做简单介绍。

基体刻蚀法也就是湿法转移技术，其核心思想是用PMMA胶作为中间载体，之后再去除PMMA。基本流程是首先在生长石墨烯的衬底表面旋涂一层PMMA，控制好PMMA薄膜的厚度，接着配制过硫酸铵溶液，并将PMMA/石墨烯/CVD衬底置于溶液中，腐蚀铜箔后，PMMA/石墨烯漂浮在液面上，用去离子水替换过硫酸铵，清洗石墨烯，然后用新的Si-SiO2衬底在去离子水中捞起PMMA/石墨烯，使其紧贴衬底表面，静置后烘干，最后用丙酮溶掉PMMA。该方法在2009年被首次使用，但是转移后的石墨烯存在破碎现象，后期在Li，Park等人提出的改进方法下，明显提高了石墨烯的转移质量，也使该方法成为石墨烯转移的主流方法之一。

“roll-to-roll”法第一次使用是将厘米数级的石墨烯从Ni基底“甩”到聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）上，其操作流程如图。首先，在PET上涂一层乙烯-醋酸乙烯酯（EVA），再用150℃的热滚筒将EVA/PET和石墨烯/Ni贴合在一起，接着用冷滚筒将PET/EVA/石墨烯从Ni衬底上“甩”出来，从而将石墨烯转移到目的衬底上。

电化学转移法是利用化学溶剂电解的原理来实现的，同样首先在石墨烯衬底表面旋涂PMMA作为阴极，用碳棒作为阳极，电解质为,该方法最大的优势在于保持石墨烯表面的充分完整性，并且成本低，具有良好的应用前景。

### μCVD法GFET生长原理和流程

利用μCVD法制备石墨烯的原理图如下。与传统化学气相沉积法制备石墨烯的设备构成相似，主要由反应腔体、加热系统、气路交换系统等，如图。基本原理是碳源气体和载气H2在流量计的控制下流入腔体内的加热平台，当温度和气体流量的配合控制下，碳原子在催化剂的帮助下完成从碳源气体中析出重组成石墨烯，并沉积在催化剂表面。本文方法中，SOI硅片顶层中间悬空的热台是反应区，表面淀积了一层几百纳米厚的铜层作为催化剂。SOI的顶层被刻蚀成合适的结构，以使中间热台的温度分布较均匀。特别的是，中间热台不需要打孔，碳源气体从热台的上表面吹过，在铜箔层表面被高温裂解，碳原子渗入铜层，达到饱和后自抑制，在降温过程中析出成为石墨烯。

μCVD法制备石墨烯的操作流程如下：

1、合成工艺在一个大气压下（101.325kPa）进行。

2、用氢气冲刷反应腔30分钟，施加一个小电压，使反应台温度上升。

3、逐渐增加电压到芯片成轻微的红色（Mild red color），此时温度大约达到800℃。

4、保持氢气环境20min，以去除因为之前暴露在空气中形成的自然氧化物。这个退火过程也是必需步骤。

5、逐渐增加电压，到加热台呈现明亮的橙色（Bright orange color），此时温度估计达到1000℃。

6、引入反应气。甲烷与氢气体积比率1.5%。

7、在铜催化剂协助下，甲烷分解，分解出的碳溶解进入铜层表面。当铜层表面沉积一层碳原子后，因为高温下碳原子在铜箔中的溶解度低，当铜表面覆盖一层石墨烯后会自抑制生长，从而容易生长出大面积石墨烯。

8、5min后停止加热，快速冷却，甲烷停止分解，碳淀积成石墨烯。冷却速率是决定石墨烯生长质量的关键因素。

μCVD法制备好石墨烯后按下列流程完成石墨烯的转移。

1.配制相应浓度的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）胶，在uCVD芯片石墨烯一侧旋涂一层PMMA胶，控制PMMA薄膜厚度。

2.将PMMA/石墨烯/uCVD衬底烘干，固化PMMA。

3.配制过硫酸铵溶液，并将PMMA/石墨烯/uCVD衬底置于溶液中，腐蚀铜箔后，PMMA/石墨烯漂浮在液面上。

4.用去离子水替换过硫酸铵，清洗石墨烯。

5.用Si-SiO2衬底在去离子水中捞起PMMA/石墨烯，使其紧贴衬底表面，静置后烘干。

6.将PMMA/石墨烯/Si-SiO2浸泡在丙酮，融掉PMMA。

在完成Si-SiO2上生长石墨烯后，接下来基于该基片进行GFET的制备，首先用丙酮和酒精清洗基片，并用氮气吹净，旋涂光刻胶，控制光刻机的转速和时间，保证涂胶的均匀性，之后烘烤一段时间，然后用紫外线曝光把掩膜版刻在石墨烯/Si-SiO2衬底上，再进行一次烘烤步骤，显影露出生长电极的窗口制作金属电极，最后用光学显微镜进行检查，完善GFET制备工艺。

## 本章小结

本章首先阐述了传统场效应管的结构和工作原理，得出传统场效应管的短沟道效应带来的劣势以及载流子迁移率不够高的缺点，从而引出由石墨烯作为导电沟道的GFET的结构和工作原理，从而突出其高迁移率、双极性等工作优势，接着对当前材料领域的研究热门——石墨烯的基本结构、特性进行说明，以及介绍了几种石墨烯转移技术，最后引出本文的uCVD方法制备石墨烯的工艺流程和对转移后的石墨烯/Si-SiO2衬底制备GFET过程的简介。

# 用于生长石墨烯的μCVD微芯片设计

# 相比较传统CVD制备系统，μCVD微芯片生长石墨烯具有很多天然优势，但是在微芯片的温度均匀性、稳定性，电流加热时间控制上依然存在不少挑战，这其中涉及到传热学，结构热学，流体动力学等理论，设计完备的芯片结构对热分布将产生重大影响，建立边界条件完善的仿真模型是芯片制造、后续测试的前提，同时，理论分析又为模型改进上起到了响应的依据作用。本章先从μCVD出发，对比传统CVD系统，从理论上分析μCVD在加热时间、气体交换、层流稳温上具备的优势，然后对用来生长石墨烯的μCVD微芯片进行结构建模，并结合ANSYS软件，在电、热、力上进行多物理场偶尔仿真并比较。

## μCVD系统的理论模型分析

## 化学气相沉积(CVD)已被广泛用在衬底上合成薄膜器件，并且成为生长纳米材料的重要方法，并且这一系统正逐步微型化。在利用CVD方法合成纳米材料会面临几个挑战：1.高热容意味着加热、冷却时间将花费很长时间；2.反应腔体的大容积意味着气体交换更复杂；3.气体流速快容易形成紊流，对生长石墨烯的质量产生影响。本节将从升降温、气体交换、气体流动状态三个方面进行理论分析，来解释μCVD在生长纳米材料过程中的“尺寸效应”，从而解决传统CVD遭遇的问题。

### 温度稳定时间模型

### 传热是因为存在温差而导致的热能转移，转移方式因介质不同而产生差异，众所周知，传热模式分为热传导、热对流及热辐射。稳态下分析μCVD芯片的温度分布就得知道各种传热模式的速率方程及物理机理。

热传导是物质中质点之间相互作用的结果，由于分子的随机运动，加上能量的分布不均，在相邻分子发生碰撞的同时，能量较大的分子会向能量较小的分子运动。热传导的速率方程可以用一维单壁模型来描述，通过分析速率方程可以知道单位时间内在物质中传递能量的多少。热传导的速率方程为：

 （3.1）

热流密度表示单位面积沿方向传热的速率，很明显，它与材料热导率和方向上的温度梯度成正比。μCVD芯片极大的宽高比可以被假设为一维单壁结构，且在稳态和单壁温度线性分布的情况下，,则带入上式得到热流密度为

 （3.2）

于是，假设芯片底面面积为A，则芯片热传导传热速率为。

热对流一方面由分子的随机运动导致的能量传输，另一方面流体的整体运动也会带走热量。根据流体的性质也可将对流分为受迫对流和自然对流。本文讨论的是流体的内部热能，也就是显热，有时候，热对流还会发生潜热交换，即换热过程伴随着流体相态的改变。不管流体性质如何，其速率方程都可以用下面表达式描述

 （3.3）

式中，热流密度与对流换热系数有关，同时与流体温度和芯片表面温度差成正比。此式也称为牛顿冷却公式，其关键在于求对流换热系数，该参数与流体的运动特性和芯片表面的几何形状有关。仿真过程中假设该经验值为已知的，下表是自然对流和受迫对流下换热系数的典型值，可作仿真时参考。

热辐射是由于物质本身的组成成分发生电子排列位置的改变造成的，不管物质何种形态，都将通过电磁波的形式进行传输，考虑芯片表面的热辐射模型，定义单位面积在单位时间内发射的能量，理想黑体热辐射的发射速率由斯蒂芬-波尔茨曼定律给出

 （3.4）

其中，是芯片表面的温度，称为斯蒂芬-波尔茨曼常数，实际情况下，表面辐射的发射速率比理想黑体小，由下式给出

 （3.5）

并称为发射率，值，实际表征表面的辐射强度，同样与表面的几何形状、粗糙程度有关，下表给出常见的发射率数据。

芯片表面既向外辐射能量也吸收来自周围环境的热辐射，假设芯片表面的吸收率和发射率相同，则表面辐射出去的能量与来自环境热辐射的能量之差为

 （3.6）

即为单位面积表面的净辐射速率。为方便起见，引入和热对流换热系数相对等的辐射换热系数，因为推导得

 （3.7）

由传热的3种模式引入热阻的概念，相较于电阻是电动势与电子迁移速率的关系，热阻可以定义为温度势与传热速率的比值，由式（3.2）可以得到平壁的导热热阻为

 （3.8）

同样地，由式（3.3）和（3.6）可以得到平壁的对流热阻和辐射热阻为

 （3.9）

 （3.10）

μCVD芯片由催化剂Cu，氧化层SiO2，以及衬底Si三层平壁组成的复合壁，总热阻为

 （3.11）

其中，。

当然，不同材料之间的交界面还存在一定程度的温度降，这是由于接触热阻导致的，接触热阻深受材料表面的粗糙程度影响，而μCVD芯片是基于SOI晶圆工艺制作，假设不同材料层紧密接触，所以忽略不同接触层中的传热温降。

前面讨论的传热过程是没有内热源的情况，温度分布与不同表面的温度差以及边界条件确定，μCVD系统相较于传统CVD的炉温加热，不同的是采用给微芯片供电，通过焦耳热的方式由内及外生热，也就是在微芯片内部发生能量转换，即讨论有内热源情况下的温度分布。

设一基于SOI晶圆的基础加热芯片结构如图所示，并将其放入一个密封腔内通电加热，根据焦耳定律，得到芯片产生的内热源能量为：



其中，为通入芯片的电流大小，为芯片通电衬底层Si的电阻，有公式知芯片电阻与（硅衬底的电阻率）、（微芯片长度）和（电流通过的有效横截面积）有关。根据热力学守恒定律，焦耳定律产生的能量，除了芯片本身吸收后内能的提高（温度升高）外，还有一部分因发生热辐射和热对流而消耗，所以



为芯片内能的增加，和分别为因热辐射和热对流而消耗的能量。由于芯片体积小，所用材料的热导率都比较高，并且各层厚度小紧密接触，因此可以认为芯片整体温度变化一致，从而芯片内能的增加转换为温度变化就是

、为各层材料（自顶向下计）的比热容和质量，是芯片加热前后的温度差，由式（3.3）和（3.6）推导热对流和热辐射消耗的能量为





同样地，为对流换热系数，为斯蒂芬-波尔兹曼常数，为第层材料的发射率，为第层材料的外表面积，、分别为反应腔内流体和腔内壁的温度。

在基本芯片形状和输入电流不变的情况下，可采用数值化的迭代法来近似求解加热过程曲线，并取时间间隔为，则公式进一步转化为

由此可得到加热后的温度公式如下：



上式中，、分别为第个加热时间段的初态温度和终态温度，且℃。

传统CVD系统的炉体尺寸达到米数量级，极大的热容量将导致系统花费数小时来完成生长环境的加热冷却过程，其中偶尔也会发生误反应，有时某些薄膜的生长过程需要快速进行，否则影响其生长质量，举个例子,ZnO纳米线的合成就需要快速升降温，以免由于升温太慢，导致薄膜或者其他微晶粒在低温区域生长，为了更好地分析系统升降温时间，我们假设系统热容量和热阻，得到系统时间常数。系统的热容量正比于加热腔体的体积，假设加热立方平台边长，则热容量正比于，则整个系统的传热速率简化为



所以热阻，很明显，热阻正比于。由前面的公式得到系统时间常数正比于，传统CVD系统的尺寸为米数量级，通过缩小其反应平台的尺寸到毫米级，可以大大缩短达到温度稳态的时间，通过理论分析和软件仿真，通过精确的电流控制，甚至加热、冷却时间可以缩短到秒级，从而避免了反应过程中易出现的副作用。

### \*\*\*\*

### 

### \*\*\*\*

## μCVD微芯片建模与仿真

### ANSYS有限元分析软件简介

### μCVD微芯片结构设计及比较

### μCVD微芯片多物理场耦合仿真

## 仿真结果与讨论

## 本章小结

# μCVD温度测控系统

## 温度检测技术原理

### 温度检测技术简介

### 基于红外辐射的测温原理

### 温度检测系统误差分析

## 温度控制技术原理

### \*\*\*\*

### \*\*\*\*

### \*\*\*\*

## 温度测控系统硬件设计

### 硬件开发平台介绍

### 硬件整体原理图及PCB设计

## 温度测控系统软件设计

### **软件开发平台介绍**

### **温度检测程序设计**

### 温度控制程序设计

## 本章小结

# μCVD显微成像系统

## 自动聚焦技术

### 传统自动聚焦基本原理

### 自动聚焦优化算法

### 优化算子比较及分析

## 图像拼接技术

### 图像拼接原理

### 图像预处理

### 图像匹配

### 图像融合

## 显微成像系统设计

### 显微成像总体设计

### 图像采集模块

### 图像拼接模块

## 本章小结

# μCVD系统使用及说明

## \*\*\*\*

## \*\*\*\*

### \*\*\*\*

### \*\*\*\*

## \*\*\*\*

### \*\*\*\*

### \*\*\*\*

### \*\*\*\*

### \*\*\*\*

## 本章小结

# 总结与展望

## \*\*\*\*

## \*\*\*\*

参考文献

致 谢